

دانشکده مهندسی برق

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک ۱ آزمایش شماره ۸:

تهیه کننده و نویسنده:

رضا آدینه پور

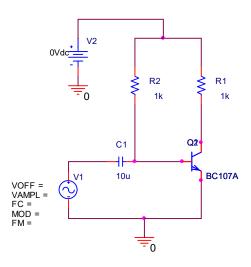
استاد مربوطه:

جناب اقای مهندس میثمی فر

تاریخ تهیه و ارائه:

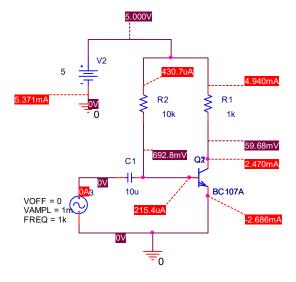
آذر ماه ۱۴۰۰

مدار شکل زیر را در اسپایس می بندیم و با تغییر مقاومت Rx نقطه کار نرانزیستور را در وسط خط بار DC قرار می دهیم سپس نقطه کار را اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت می کنیم.



طبق فرمول زیر، مقادیر ولتاژی و مقاومت R2 را به صورت زیر انتخاب کردیم:

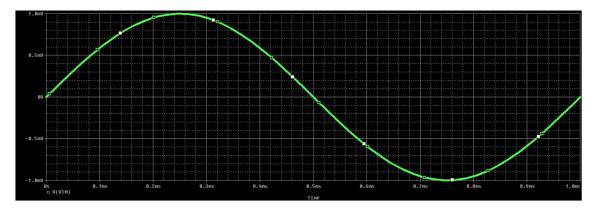
$$I_{CQ} = \frac{Vcc - Vce, sat}{Rdc + Rac} = \frac{5 - 0.2}{1 + 1} = 2.4 \text{ mA}$$



VBEQ(V)	0.69
VCEQ(V)	0.59
Ic(mA)	2.47
Rx(Kohm)	10
VRX(V)	4.308
IB(uA)	215.4
hFE	11.5

سیگنال ژنراتور را روشن کنید و با انتخاب فرکانس حدود ۱ کیلو هرتز ورودی را طوری تنظیم کنید که خروجی اعوجاج نداشته باشد. ولتاژ ورودی و خروجی را در جدول زیر یاداشت نمایید و بهره ولتاژ را معین کنید.

سیگنال ورودی مدار به صورت زیر است: با دامنه ۱ میلی ولت



سیگنال تقویت شده به صورت زیر است:



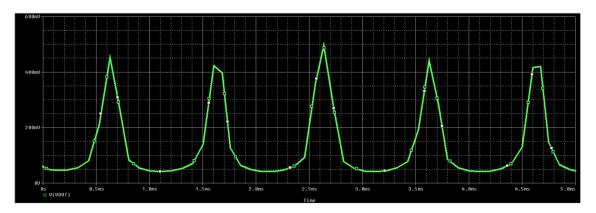
مشاهده می شود که دامنه سیگنال خروجی ۶۳ برابر شده است

در نتیجه بهره این ساختار ۶۳ است.

کانال مربوط به خروجی اسکوپ را روی حالت DC قرار دهید و دامنه سیگنال ورودی را آنقدر زیاد کنید که تا سیکل منفی موج از پایین در حال زده شدن باشد. حال دوباره هویه را به بدنه ترانزیسور بچسبانید و به اعوجاج سیگنال خروجی توجه کنید. ترانزیستور در این حالت در چه ناحیه ای کار می کند؟

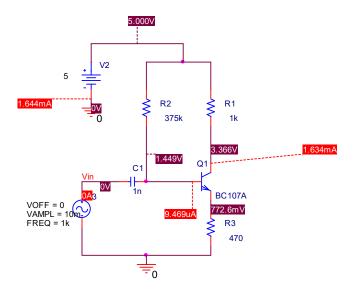
دامنه سیگنال ورودی را روی ۱۰ میلی ولت تنظیم میکنیم و مشاهده می شود که سیگنال خروجی از پایین جایی برای سویینگ ندارد.

سیگنال خروجی به صورت زیر است:



ترانزیستور وارد ناحیه اشباع میشود.

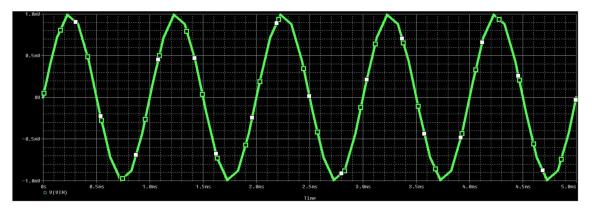
این بار مدار شکل زیر را می بندیم و آزمایش را تکرار می کنیم:



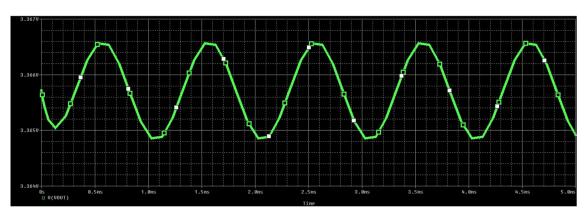
VBEQ(V)	0.72
VCEQ(V)	2.59
Ic(mA)	1.63
Rx(Kohm)	375
VRX(V)	3.55
IB(uA)	9.46
hFE	172

سیگنال ژنراتور را روشن کنید و با انتخاب فرکانس حدود ۱ کیلو هرتز ورودی را طوری تنظیم کنید که خروجی اعوجاج نداشته باشد. ولتاژ ورودی و خروجی را در جدول زیر یاداشت نمایید و بهره ولتاژ را معین کنید.

سیگنال ورودی مدار به صورت زیر است: با دامنه ۱ میلی ولت



سیگنال تقویت شده به صورت زیر است:



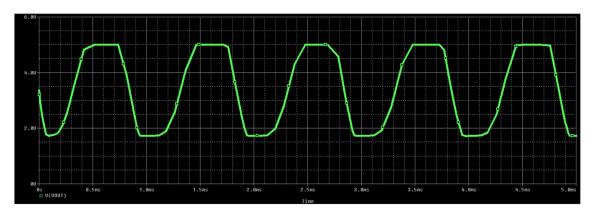
مشاهده می شود که دامنه سیگنال خروجی ۳.۳ برابر شده است

در نتیجه بهره این ساختار ۳.۳ است.

کانال مربوط به خروجی اسکوپ را روی حالت DC قرار دهید و دامنه سیگنال ورودی را آنقدر زیاد کنید که تا سیکل منفی موج از پایین در حال زده شدن باشد. حال دوباره هویه را به بدنه ترانزیسور بچسبانید و به اعوجاج سیگنال خروجی توجه کنید. ترانزیستور در این حالت در چه ناحیه ای کار می کند؟

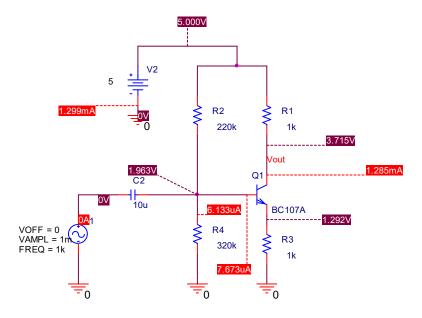
دامنه سیگنال ورودی را روی ۳ ولت تنظیم میکنیم و مشاهده می شود که سیگنال خروجی از پایین و بالا جایی برای سویینگ ندارد.

سیگنال خروجی به صورت زیر است:



ترانزیستور وارد ناحیه اشباع میشود.

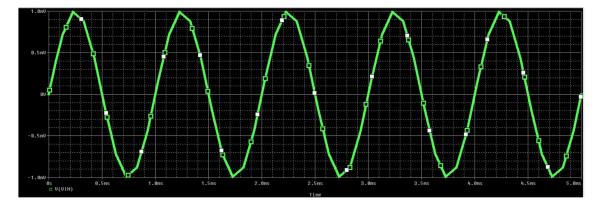
این بار مدار شکل زیر را می بندیم و آزمایش را تکرار می کنیم:



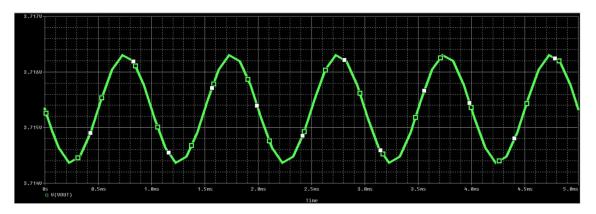
VBEQ(V)	0.671
VCEQ(V)	2.42
Ic(mA)	1.28
Rx(Kohm)	320
VRX(V)	3.04
IB(uA)	7.67
hFE	274

سیگنال ژنراتور را روشن کنید و با انتخاب فرکانس حدود ۱ کیلو هرتز ورودی را طوری تنظیم کنید که خروجی اعوجاج نداشته باشد. ولتاژ ورودی و خروجی را در جدول زیر یاداشت نمایید و بهره ولتاژ را معین کنید.

سیگنال ورودی مدار به صورت زیر است: با دامنه ۱ میلی ولت



سیگنال تقویت شده به صورت زیر است:



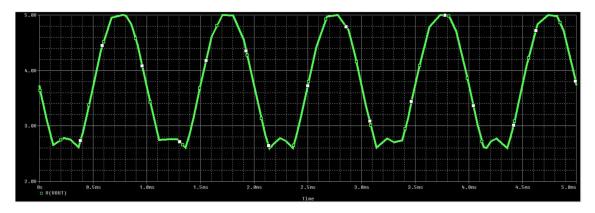
مشاهده می شود که دامنه سیگنال خروجی ۳.۷ برابر شده است

در نتیجه بهره این ساختار ۳.۷ است.

کانال مربوط به خروجی اسکوپ را روی حالت DC قرار دهید و دامنه سیگنال ورودی را آنقدر زیاد کنید که تا سیکل منفی موج از پایین در حال زده شدن باشد. حال دوباره هویه را به بدنه ترانزیسور بچسبانید و به اعوجاج سیگنال خروجی توجه کنید. ترانزیستور در این حالت در چه ناحیه ای کار می کند؟

دامنه سیگنال ورودی را روی ۱.۵ ولت تنظیم میکنیم و مشاهده می شود که سیگنال خروجی از پایین جایی برای سویینگ ندارد.

سیگنال خروجی به صورت زیر است:



ترانزیستور وارد ناحیه اشباع میشود.

کدام یک از مدار های داده شده دارای بیشترین پایسداری می باشد؟ کدام یک دارای بیشترین بهره ولتاژ می باشد؟

مدار شماره یک بیشترین بهره را دارد (ساختار امیتر مشترک) و پایداری انها به یک میزان است.